

Ruido

Ezequiel Rubinsztain erubinsztain@fi.uba.ar



Calendario

Capítulo 1: Introducción

- · Clase 1: Transistores Bipolar y MOS. Pequeña señal. Circuitos monoetapas
- · Clase 2: Cadence Introducción y Circuitos monoetapas
- · Clase 3: Par diferencial. Amplificador diferencial. Implementación básica

Capítulo 2: Respuesta en Frecuencia y Estabilización

- Clase 4: Amplificador operacional: Respuesta en frecuencia, estabilidad.
 Capacidades asociadas al transistor MOS
- Clase 5: Cadence Amplificador operacional. Operación en DC, offset sistemático, ganancia
- · Clase 6: Estabilización, Miller, cero asociado, compensaciones avanzadas
- · Clase 7: Cadence Amplificador operacional. Respuesta en frecuencia, estabilidad



Calendario

Capítulo 3: Amplificadores Avanzados

- Clase 8: Amplificadores avanzados. Current mirror opamp, cascode, folded amplifier, folded cascode.
- · Clase 9: Amplificadores avanzados. Push-pull output, Diff-diff, CMFB
- Clase 10: Cadence Amplificadores avanzados

Capítulo 4: Ruido y Offset

• Clase 11: Offset

• Clase 12: Ruido

• Clase 13: Cadence - Diseño con offset y ruido

Capítulo 5: Circuitos Auxiliares

- · Clase 14: Circuitos auxiliares. Referencias, bandgap, osciladores
- Clases 15 y 16: Extra Introducción al diseño físico de semiconductores (layout)



Contenido Clase 12

- Ruido:
 - Introducción a ruido
 - Ruido en resistencias
 - Ruido en bipolares
 - · Ruido en mos
 - Ruido en amplificadores
 - · Técnicas de eliminación de offset y ruido flicker

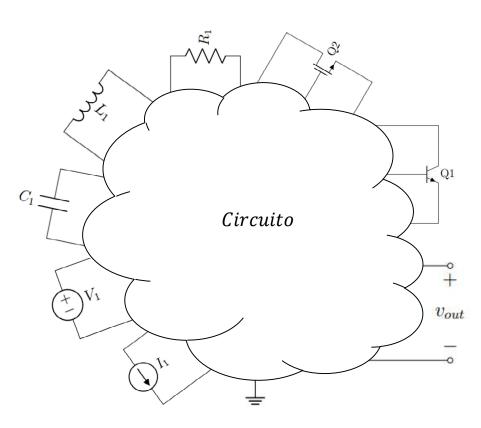


Contenido Clase 12

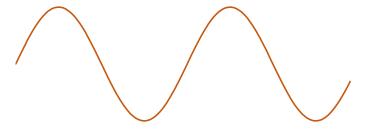
- Ruido:
 - Introducción a ruido
 - Ruido en resistencias
 - Ruido en bipolares
 - Ruido en mos
 - Ruido en amplificadores
 - Técnicas de eliminación de offset y ruido flicker



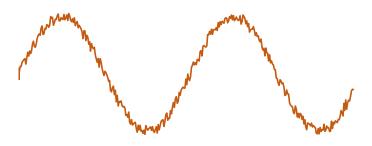
Introducción a ruido



• Antes de medir la señal *Vout* del circuito esperamos:



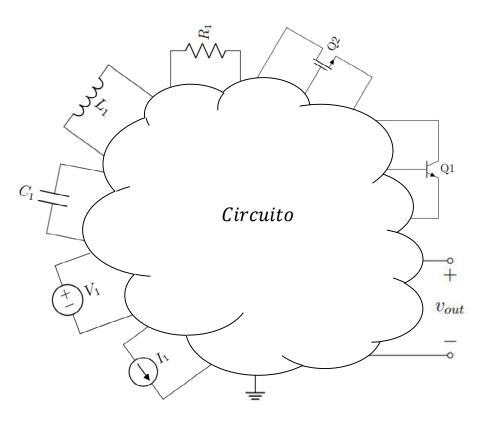
• Cuando la medimos, vemos:



• La razón: <u>ruido</u>



Introducción a ruido



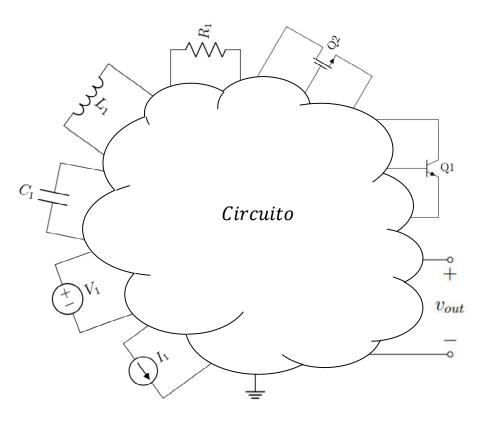
• Por lo tanto *vout* será:

$$\cdot vout(t) = \overline{vout(t)} + vout_n(t)$$

- La señal $vout_n$ es lo que llamamos ruido y es generada por todos los elementos que componen el circuito con excepción de capacitores e inductores. Dependiendo del elemento, algunas de las causas del ruido son:
 - Movimiento aleatorio de electrones en materiales resistivos.
 - Recombinación aleatoria de huecos y electrones en semiconductores.
 - Difusión aleatoria de huecos y electrones a través de una barrera de potencial
- $vout_n(t)$ se modela como un proceso estocástico estacionario en sentido amplio de media cero.



· Introducción a ruido



• Por lo tanto podemos establecer la función de correlación de $vout_n(t)$ como:

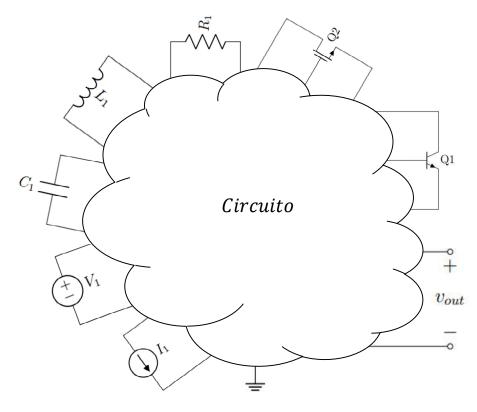
$$C_{vout_n}(\tau) = E[vout_n(t) \cdot vout_n(t-\tau)]$$

• La densidad espectral de potencia (PSD) del ruido, se obtiene aplicando la transformada de Fourier a la función de correlación:

•
$$PSD_{vout_n}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} C_{vout_n}(\tau) \cdot e^{-j2\pi \cdot f \cdot \tau} \cdot 2\pi \cdot df$$



Introducción a ruido



• Podemos ver que para τ =oseg, la función de correlación es la varianza de $vout_n$:

•
$$C_{vout_n}(0) = E[vout_n(t) \cdot vout_n(t)] = \sigma_{vout_n}^2$$

• Y se puede calcular también como:

•
$$\sigma_{vout_n}^2 = \int_{-\infty}^{\infty} PSD_{vout_n}(f) \cdot df$$

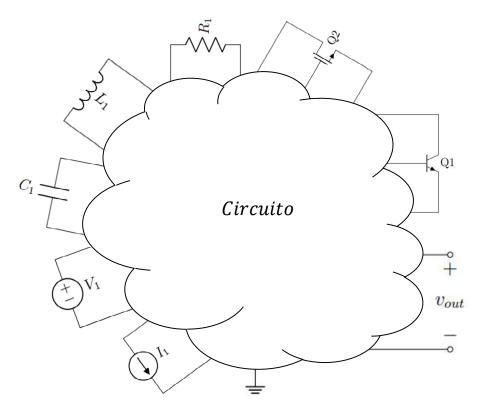
• Recuerden que, si pasáramos $vout_n$ a través de un filtro A(f):

•
$$PSD_{filt.vout_n}(f) = PSD_{vout_n}(f) \cdot |A(f)|^2 y$$

• $\sigma_{filt.vout_n}^2 = \int_{-\infty}^{\infty} PSD(f) \cdot |A(f)|^2 \cdot df$



Introducción a ruido



• Para obtener $C_{vout_n}(\tau)$, se trabaja en el espectro. Se busca obtener $PSD_{vout_n}(f)$. Para ello se deben sumar las contribuciones al ruido (se asumen independientes):

•
$$PSD_{vout_{\underline{n}}}(f) = |T_{n_{R_{\underline{1}}}}(f)|^{2} \cdot PSD_{n_{R_{\underline{1}}}}(f) + |T_{n_{Q_{\underline{1}}}}(f)|^{2} \cdot PSD_{n_{Q_{\underline{1}}}}(f) + |T_{n_{Q_{\underline{1}}}}(f)|^{2} \cdot PSD_{n_{Q_{\underline{1}}}(f)}(f) + |T_{n_{Q_{\underline{1}}}(f)|^{2} \cdot PSD_{n_{Q_{\underline{1}}(f)}(f) + |T_{n_{Q_{\underline{1}}}(f)|^{2} \cdot PSD_{n_{Q_{\underline{1}}(f)}(f)}(f) + |T_{n_{Q_{\underline{1}}(f)}(f)|^{2} \cdot PSD_{n_{Q_{\underline{1}}(f)}(f) + |T_{n_{Q_{\underline{1}}(f)}(f)|^{2} \cdot PSD_{n_{Q_{\underline{1}}(f)}(f) + |T_{n_{Q_{\underline{1}}(f)}(f)|^{2} \cdot PSD_{n_{Q_{\underline{1}}(f)}(f)}(f) + |T_{n_{Q_{\underline{1}}(f)}(f)|^{2} \cdot PSD_{n_{Q_{\underline{1}}(f)}(f)}(f) + |T_{n_{Q_{\underline{1}}(f)}(f)|^{2} \cdot PSD_{n_{Q_{\underline{1}}(f)}(f)}(f) + |T_{n_{Q_{\underline{1}}(f)}(f)|^{2} \cdot PSD_{n_{Q_{\underline{1}}(f)}(f)}(f) + |T_{n_{Q_{\underline{1}}(f)}(f)|^{2} \cdot PSD_$$

• Siendo $T_{n_E}(f)$ la transferencia de la fuente de ruido del elemento E a vout y $PSD_{n_E}(f)$ la densidad espectral de potencia de la fuente de ruido del elemento E.

10

 Nos proponemos estudiar las fuentes de ruido de los principales elementos: resistencias, transistores bipolares y mos.



· Tipos de Ruido

· Ruido Térmico:

 También llamado ruido blanco, es generado cuando energía térmica causa que electrones libres se muevan en forma aleatoria en un material resistivo. La densidad de potencia espectral es independiente de la frecuencia. Se asume una distribución Gaussiana.

Shot Noise:

• Debido a tiempo de paso aleatorio de minoritarios atravesando una barrera de potencial. Al igual que el ruido térmico, se asume independiente a la frecuencia y con distribución gaussiana.

Ruido Flicker:

- También llamado, ruido de contacto, ruido 1/f o ruido rosa, este fenómeno es debido a imperfecciones en el contacto entre materiales conductores donde las cargas quedan atrapadas o liberadas en la interface. Es fuertemente dependiente de la frecuencia teniendo una densidad de potencia espectral del orden de K/f. Ejemplos:
 - · Contactos de switches, potenciómetros o relés.
 - Debido al contacto de las partículas del material resistivo. Por ejemplo son mejores las de metal film versus las de carbón.
 - Transistores Bipolares y Mos presentan este tipo de ruido.

Burst Noise:

• También conocido como popcorn noise, es causado por impurezas metálicas en junturas P-N. Puede ser minimizado mejorando el proceso de fabricación, es visto como pulsos de amplitud fija y ancho y repetición aleatorias.

2C-2024

11



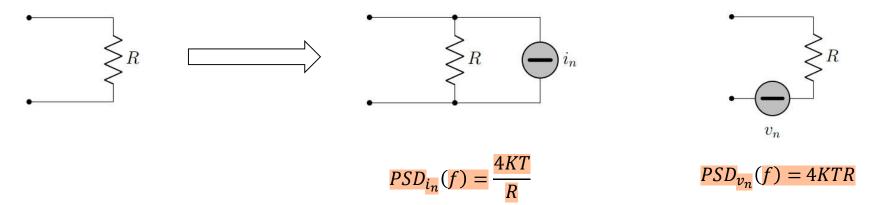
Contenido Clase 12

- Ruido:
 - Introducción a ruido
 - Ruido en resistencias
 - Ruido en bipolares
 - Ruido en mos
 - Ruido en amplificadores
 - Técnicas de eliminación de offset y ruido flicker

2C-2024 **12**



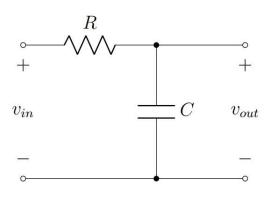
Ruido en resistencias



- Ruido en resistencias:
 - · Generado únicamente por ruido térmico.
- La fuente de ruido se puede modelar indistintamente como una fuente de corriente o tensión con:
 - K: constante de Boltzman. Ej. 1,380649 × 10–23 J/°K.
 - T: temperatura en grados Kelvin. Ej. T=300°K (27°C).
 - R: resistencia del material. Ej. R = $1K\Omega$.
 - Tomando los ejemplos: $PSD_{v_n}at\ 27\ ^{\circ}C \approx 16.56\frac{nV^2}{Hz}$ o $4.07\frac{nV}{\sqrt{Hz}}$ or $PSD_{i_n}at\ 27\ ^{\circ}C \approx 16.56\frac{pA^2}{Hz}$ o $4.07\frac{pA}{\sqrt{Hz}}$



Ruido en resistencias



- Ejemplo:
 - * Calcular el PSD y el sigma de ruido que introduce el filtro en v_{out} .
- Solución:
 - La única fuente de ruido es la resistencia R. Que introduce una fuente serie con:

•
$$PSD_{v_n}(f) = 4KTR$$

• Luego, se debe calcular la transferencia de la fuente de ruido a la salida que es:

•
$$\left| \frac{v_{out}}{v_n} (f) \right|^2 = \frac{1}{(1 + (2\pi f R)^2)}$$

• Entonces:

•
$$PSD_{v_{out}}(f) = \frac{4KTR}{(1+(2\pi fRC)^2)}$$

• Para encontrar la varianza debemos integrar:

•
$$\sigma_{v_{out}}^2 = \int_0^\infty PSD_{v_{out}}(f) \cdot df = \frac{KT}{C}$$

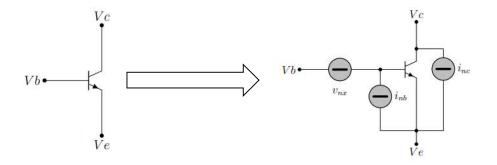


Contenido Clase 12

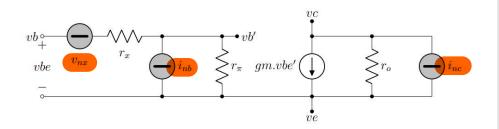
- Ruido:
 - Introducción a ruido
 - Ruido en resistencias
 - Ruido en bipolares
 - Ruido en mos
 - Ruido en amplificadores
 - · Técnicas de eliminación de offset y ruido flicker

2C-2024 **15**





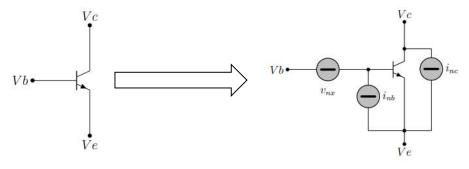
$$\begin{aligned} & PSD_{v_{nx}}(f) = 4KTR_{x} \\ & PSD_{i_{nb}}(f) = 2qI_{B} + K_{1}\frac{I_{b}^{a}}{f} + K_{2}\frac{I_{b}^{c}}{1 + (\frac{f}{f_{c}})^{2}} \approx 2KT\frac{g_{m}}{\beta} \\ & PSD_{i_{nc}}(f) = 2qI_{c} = 2KTg_{m} \end{aligned}$$



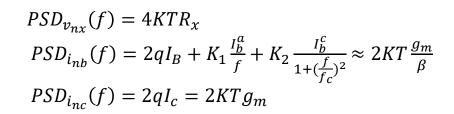
16

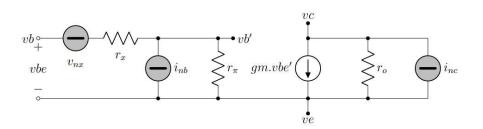
- El ruido del transistor bipolar proviene de varias fuentes:
 - Ruido térmico que se produce en la resistencia física de base r_x . Se representa como v_{nx} .
 - Shot noise de corriente de colector: debido a tiempo de paso aleatorio de minoritarios atravesando la juntura colector base. Se modelan con la corriente i_{nc} .
 - Shot noise de corriente de base, junto con efectos experimentales como flicker y burst se agrupan en i_{nb} . Generalmente se desprecian los efectos flicker y burst.





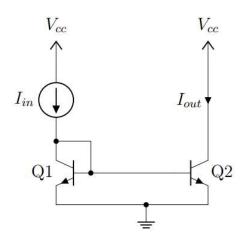
- · Los principales parámetros:
 - K: constante de Boltzman: 1,380649 × 10–23 J/°K.
 - q: carga del electrón: 1,602176565 × 10–19 C.
 - T: temperatura en grados Kelvin. Ej. T=300°K (27°C).
 - Rx: resistencia de la difusión de la base. Ej. R = 25Ω .
 - Ib, Ic: corriente de base y de colector. Ej. Ib=100nA y Ic=10uA.
 - gm: transconductancia. Ej. gm= 387 uA/V (27°C and Ic 10uA).
 - β: ganancia de Corriente Ic/Ib. Ej. 100 veces.
 - f: frecuencia. Ej. 10Hz.
 - Constantes del proceso K2, I_b^a y I_b^c .





- Se puede calcular, tomando los ejemplos de los parámetros (despreciando flicker y burst):
 - $PSD_{v_{nx}} \approx 0.41 \frac{nV^2}{Hz} \circ 0.64 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}$
 - $PSD_{i_{nc}} \approx 3.2 \frac{pA^2}{Hz}$ o $1.79 \frac{pA}{\sqrt{Hz}}$
 - $PSD_{i_{nb}} \approx 0.03 \frac{pA^2}{Hz} \circ 0.18 \frac{pA}{\sqrt{Hz}}$





$$Q_1 = Q_2$$

- Ejemplo:
 - Calcular el densidad espectral de ruido de lout para frecuencias bajas y a 27C , asumiendo lin 10uA y rx 25 Ω . ¿Se puede despreciar el ruido i_{nb} ? Despreciar corriente de flicker y burst.
- Solución:
 - Calculamos en pequeña señal para las fuentes de ruido de los elementos Q1 y Q2 para formar:

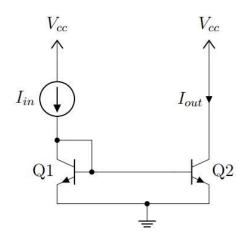
$$PSD_{iout}(f) = PSD_{iout}^{i_{nc1}}(f) + PSD_{iout}^{i_{nc}}(f) + PSD_{iout}^{i_{nb1}}(f) + PSD_{iout}^{i_{nb2}}(f) + PSD_{iout}^{i_{nb2}}(f) + PSD_{iout}^{i_{rx2}}(f) + PSD_{iout}^{i_{rx2}}(f) + PSD_{iout}^{i_{rx2}}(f) + PSD_{iout}^{i_{rx2}}(f) + PSD_{iout}^{i_{rx3}}(f) + P$$

• Calculamos primer $PSD_{i_{out}}^{i_{nc1}}(f)$ y $PSD_{i_{out}}^{i_{nc2}}(f)$

•
$$i_{out}^{i_{nc1}} = \frac{gm_2}{gm_1}i_{nc1} = i_{nc1} \to PSD_{i_{out}}^{i_{nc1}}(f) = 2KTg_{m_1} = 2KTg_m$$

•
$$i_{out}^{i_{nc}} = i_{nc2} \rightarrow PSD_{i_{out}}^{i_{nc}}(f) = 2KTg_{m_2} = 2KTg_m$$





$$Q_1 = Q_2$$

- Solución (cont. slide anterior):
 - Calculamos primer $PSD_{i_{out}}^{i_{nb1}}(f)$ y $PSD_{i_{out}}^{i_{nb}}(f)$

•
$$i_{out}^{i_{nb1}} = \frac{gm_2}{gm_1} i_{nb1} = i_{nb1} \to PSD_{i_{out}}^{i_{nb1}}(f) = 2KT \frac{gm_1}{\beta}$$

• $i_{out}^{i_{nb}} = \frac{gm_2}{gm_1} i_{nb2} = i_{nb2} \to PSD_{i_{out}}^{i_{nc2}}(f) = 2KT \frac{gm_2}{\beta}$

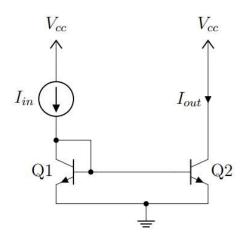
- Como vemos son β veces menores que el ruido de la corriente de colector. Por lo tanto, podemos despreciar esta fuente de ruido.
- Calculamos primer $PSD_{i_{out}}^{v_{r_{\chi_1}}}(f)$ y $PSD_{i_{out}}^{v_{r_{\chi_2}}}(f)$
 - Despreciando rx en el análisis de pequeña señal se obtiene:

•
$$i_{out}^{v_{r_{x_1}}} \approx g_{m_2} v_{r_{x_1}} \to PSD_{i_{out}}^{v_{r_{x_1}}}(f) \approx 4KTr_x \cdot gm_2^2 = 4KTr_x \cdot g_m^2$$

• $i_{out}^{v_{r_{x_2}}} \approx g_{m_2} v_{r_{x_2}} \to PSD_{i_{out}}^{v_{r_{x_2}}}(f) \approx 4KTr_x \cdot gm_2^2 = 4KTr_x \cdot g_m^2$

2C-2024 **19**





$$Q_1 = Q_2$$

- Solución (cont. slide anterior):
 - Juntando todos los resultados:

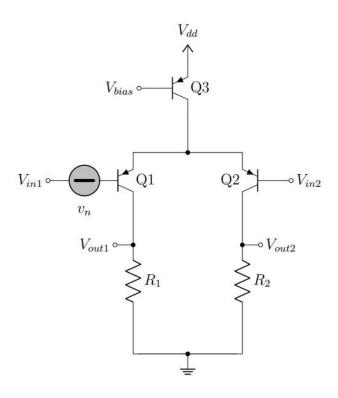
•
$$PSD_{i_{out}}(f) = PSD_{i_{out}}^{i_{nc1}}(f) + PSD_{i_{out}}^{i_{nc2}}(f) + PSD_{i_{out}}^{v_{r_{x1}}}(f) + PSD_{i_{out}}^{v_{r_{x2}}}(f)$$

•
$$PSD_{i_{out}}(f) = 2 * 4KT(g_m/2 + r_x \cdot g_m^2) = 4KTg_m(1 + 2 \cdot r_x \cdot g_m)$$

- Calculamos gm para 10uA: 400uA/V
- Vemos que $2 \cdot r_x \cdot g_m$ es << 1
- $PSD_{i_{out}}(f) \approx 4KTg_m = 6.62 \frac{pA^2}{Hz} o 2.57 \frac{pA}{\sqrt{Hz}}$
- · Podemos pensar una resistencia equivalente de ruido:

•
$$\frac{4KT}{R_{eq}} = 4KTg_m$$
 obteniendo: $R_{eq} = \frac{1}{g_m} = 2.5K\Omega$





$$I_{c3} = I_{bias} = 2I_c; Q_1 = Q_2$$

 $R_1 = R_2 = R$

• Ejemplo:

• Calcular la densidad espectral de potencia a bajas frecuencias y a 27C referida a la entrada v_n . Asumir Ibias 20uA,R 48K Ω , rx 25 Ω y despreciar las corrientes de ruido flicker y burst.

Solución:

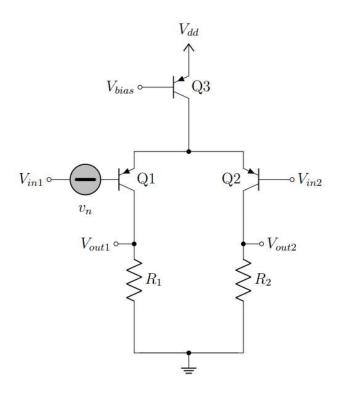
· La ganancia diferencial del circuito es:

•
$$\frac{v_{out2} - v_{out1}}{v_{diff}} = \frac{v_{out}}{v_{diff}} = gm_{diff}R$$

- Los elementos que aportan al ruido son Q1, Q2, Q3, R1 y R2.
- Q₃ se puede despreciar dado que sus aporte es de modo común.
- Dada la simetría del circuito podemos asumir que Q1 y Q2 aportan lo mismo, al igual que R1 y R2.

21





$$I_{c3} = I_{bias} = 2I_c; Q_1 = Q_2$$

 $R_1 = R_2 = R$

Solución (cont. slide anterior):

Para las resistencias tenemos que cada una aporta:

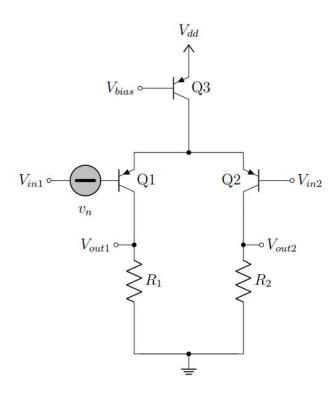
•
$$PSD_{v_n}^R(f) = \frac{4KTR}{(gm_{diff}R)^2} = \frac{4KT}{gm_{diff}(gm_{diff}R)}$$

Para los bipolares:

- Dado que conectamos a tierra la entrada cuando calculamos la contribución a v_{out} , podemos decir que el aporte de ruido de las corrientes de base a la salida diferencial va a ser cero (quedan en corto-circuito con la tierra virtual en los emisores).
- Por otro lado el aporte de ruido de las resistencias de base queda directamente sumando a la entrada v_n .
- Por ultimo, para las corrientes de colector calculamos la transferencia a v_{out} y luego dividimos por la ganancia diferencial al cuadrado:

•
$$PSD_{v_n}^Q(f) = 4KTr_x + \frac{2KTgm_{diff}R^2}{(gm_{diff}R)^2} = 4KT(r_x + \frac{1}{2g_{diff}})$$





$$I_{c3} = I_{bias} = 2I_c; Q_1 = Q_2$$

 $R_1 = R_2 = R$

Solución (cont. slide anterior):

· De lo encontrado

•
$$PSD_{v_n}^R(f) = \frac{4KTR}{(gm_{diff}R)^2} = \frac{4KT}{gm_{diff}(gm_{diff}R)}$$

• $PSD_{v_n}^Q(f) = 4KTr_x + \frac{2KTgm_{diff}R^2}{(gm_{diff}R)^2} = 4KT\left(r_x + \frac{1}{2g}\right)$

· Podemos obtener:

$$PSD_{v_n}(f) = 2 \cdot \left(PSD_{v_n}^R(f) + PSD_{v_n}^Q(f)\right)$$

$$PSD_{v_n}(f) = 2 \cdot 4KT(r_x + \frac{1}{gm_{diff}}(\frac{1}{2} + \frac{1}{gm_{diff}R}))$$

· Calculamos:

•
$$gm_{diff} \approx \frac{10uA}{25mV} = 400 \frac{uA}{V} \rightarrow \frac{1}{400 \frac{uA}{V}} = 2.5K\Omega \gg 2 \cdot r_{\chi}$$

•
$$\frac{v_{out}}{v_{diff}} = gm_{diff}R = 19.2 \gg 2$$

•
$$PSD_{v_n}(f) \approx \left(\frac{4KT}{gm_{diff}}\right) = 41.1 \frac{nV^2}{Hz}$$
 or $6.43 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}$

•
$$R_{eq} = \frac{1}{gm_{diff}} = 2.5K\Omega$$

2C-2024

23

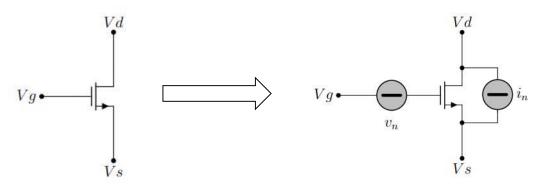


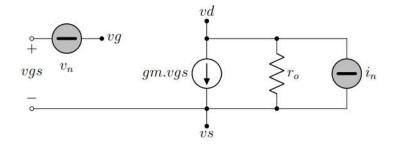
Contenido Clase 12

- Ruido:
 - Introducción a ruido
 - Ruido en resistencias
 - Ruido en bipolares
 - · Ruido en mos
 - Ruido en amplificadores
 - Técnicas de eliminación de offset y ruido flicker



$$PSD_{i_n}(f) = 4KT \frac{2}{3} g_m$$
; $PSD_{v_n}(f) = \frac{K_f}{w \cdot l \cdot c_{ox} \cdot f}$





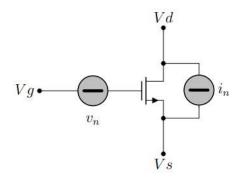
- · Ruido en mos en saturación compuesto por dos efectos:
 - Ruido térmico $PSD_{i_n}(f)$
 - Ruido flicker $PSD_{v_n}(f)$
- Para el caso de que el mos esta en la zona óhmica, el ruido se modela como a un resistor.
- El ruido se puede agrupar en v_n dividiendo i_n por g_m . Teniendo en ese caso:

•
$$PSD_{v_n}(f) = PSD_{v_n}(f) + \frac{1}{g_m^2} PSD_{i_n}(f)$$

• Del mismo modo, el ruido se puede agrupar en i_n multiplicando v_n por g_m . Teniendo en ese caso:

•
$$PSD_{\nu_n}(f) = g_m^2 \cdot PSD_{\nu_n}(f) + PSD_{i_n}(f)$$

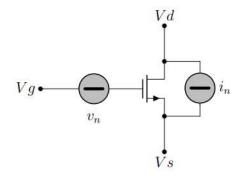




$$PSD_{i_n}(f) = 4KT \frac{2}{3} g_m$$
; $PSD_{v_n}(f) = \frac{K_f}{w \cdot l \cdot c_{ox} \cdot f}$

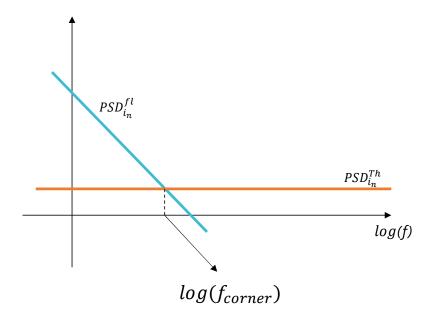
- Para PSD_{i_n} tenemos:
 - K: constante de Boltzman. Ej. 1,380649 × 10^-23 J/°K.
 - T: temperatura en grados Kelvin. Ej. 300°K (27°C).
 - gm: Transconductancia. Ej. 200 uA/V.
 - Tomando los ejemplos: $PSD_{i_n}at\ 27\ ^{\circ}C \approx 2.2 \frac{pA^2}{Hz}$ or $1.48 \frac{pA}{\sqrt{Hz}}$
- Para PSD_{v_n} tenemos:
 - Kf: Constante dependiente del proceso . Ej. 10^-25 V^2F
 - cox: capacidad por unidad de área del mos. Ej. 4 fF/um^2.
 - w: ancho del canal. Ej. 10um.
 - l: largo del canal. Ej. 10um.
 - F: frecuencia. Ej. 10Hz.
 - Tomando los ejemplos: $PSD_{v_n}at\ 10Hz\ \approx 0.025 \frac{uV^2}{Hz}$ o $0.158 \frac{uV}{\sqrt{Hz}}$
 - Referido en corriente(asumiendo gm=200uA/V):
 - $PSD_{i_n}^{fl}$ at $10Hz = g_m^2 PSD_{v_n} \approx 1000 \frac{pA^2}{Hz}$ o $31.6 \frac{pA}{\sqrt{Hz}}$



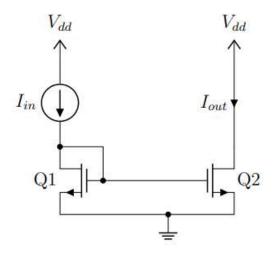


$$PSD_{i_n}(f) = 4KT \frac{2}{3} g_m$$
; $PSD_{v_n}(f) = \frac{K_f}{w \cdot l \cdot c_{ox} \cdot f}$

- Se define *corner frequency* a la frecuencia en la que se encuentran:
 - $PSD_{i_n}^{Th}(f_{corner}) = PSD_{i_n}^{fl}(f_{corner})$
 - $KT \frac{2}{3}g_m = g_m^2 \frac{K_f}{w \cdot l \cdot c_{ox} \cdot f_{corner}} \xrightarrow{\text{despejando}} f_{corner} = \frac{3g_m \cdot K_f}{2KT \cdot w \cdot l \cdot c_{ox}}$
- Del ejemplo anterior encontramos:
 - $PSD_{i_n}^{fl}(f_{corner}) = \frac{10000 \frac{pA^2}{HZ}}{f_{corner}} = PSD_{i_n}^{Th}(f_{corner}) = 2.2 \frac{pA^2}{HZ}$
 - $f_{corner} \approx 4.5 Khz$







$$Q_1 = Q_2$$

• Ejemplo:

 Calcular el densidad espectral de ruido de lout para frecuencias bajas y a 27C, asumiendo lin 10uA, K 120uA/V², Vt 0.7V, w = l = 10um y despreciar ruido flicker.

Solución:

- Calculamos en pequeña señal para las fuentes de ruido de los elementos Q1 y Q2 para formar:
 - $PSD_{i_{out}}(f) = PSD_{i_{out}}^{i_{n_1}}(f) + PSD_{i_{out}}^{i_{n_2}}(f)$
 - Calculamos primer $PSD_{i_{out}}^{i_{n_1}}(f)$ y $PSD_{i_{out}}^{i_{n_2}}(f)$

•
$$i_{out}^{i_{n1}} = \frac{gm_2}{gm_1}i_{n1} = i_{n1} \rightarrow PSD_{i_{out}}^{i_{n1}}(f) = \frac{8}{3}KTg_{m_1} = \frac{8}{3}KTg_m$$

•
$$i_{out}^{i_{n2}} = i_{n2} \rightarrow PSD_{i_{out}}^{i_{n2}}(f) = \frac{8}{3}KTg_{m_2} = \frac{8}{3}KTg_m$$

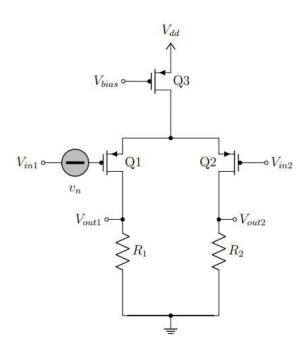
•
$$PSD_{i_{out}}(f) = \frac{16}{3}KTg_m =_{g_m=34u/V} = 0.75 \frac{pA^2}{Hz} o \ 0.86 \frac{pA}{\sqrt{Hz}}$$

· Podemos pensar una resistencia equivalente de ruido:

•
$$\frac{4KT}{R_{eq}} = \frac{16}{3} KT g_m$$
obteniendo: $R_{eq} = \frac{3}{4g_m} = 22K\Omega$

- Consideren que para la misma corriente con bipolar: $R_{eq} = 2.5 K \Omega$





$$I_{d3} = I_{bias}; Q_1 = Q_2$$

 $R_1 = R_2 = R$

• Ejemplo:

• Calcular la densidad espectral de potencia a bajas frecuencias y a 27C referida a la entrada v_n . Asumir Ibias 20UA,R 48K Ω , K = 40UA/V 2 , Vt = 0.7V, w = 40Um, l=2.5Um y despreciar ruido flicker.

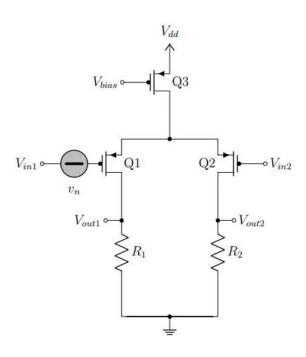
Solución:

• La ganancia diferencial del circuito es:

•
$$\frac{V_{out2} - V_{out1}}{V_{diff}} = \frac{\Delta V_{out}}{V_{diff}} = gm_{diff}R$$

- Los elementos que aportan al ruido son Q1, Q2, Q3, R1 y R2.
- Q3 se puede despreciar dado que sus aporte es de modo común.
- Dada la simetría del circuito podemos asumir que Q1 y Q2 aportan lo mismo, al igual que R1 y R2.





$$I_{d3} = I_{bias}; Q_1 = Q_2$$

 $R_1 = R_2 = R$

- Solución (cont. slide anterior):
 - Para las resistencias tenemos que cada una aporta:

•
$$PSD_{v_n}^R(f) = \frac{4KTR}{(gm_{diff}R)^2} = \frac{4KT}{gm_{diff}(gm_{diff}R)}$$

- Para Q1 y Q2:
 - Calculamos la transferencia a v_{out} y luego dividimos por la ganancia diferencial al cuadrado:

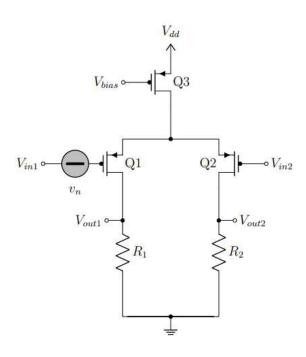
•
$$PSD_{v_n}^Q(f) = \frac{8/3 \cdot KTg \quad diff^{R^2}}{(gm_{diff}R)^2} = 4KT(\frac{2}{3gm_{diff}})$$

· Podemos obtener:

•
$$PSD_{v_n}(f) = 2 \cdot \left(PSD_{v_n}^R(f) + PSD_{v_n}^Q(f) \right)$$

•
$$PSD_{v_n}(f) = 2 \cdot 4KT(\frac{1}{gm_{diff}}(\frac{2}{3} + \frac{1}{gm_{diff}R}))$$





$$I_{d3} = I_{bias}; Q_1 = Q_2$$

 $R_1 = R_2 = R$

- Solución (cont. slide anterior):
 - · Podemos obtener:

•
$$PSD_{v_n}(f) = 2 \cdot \left(PSD_{v_n}^R(f) + PSD_{v_n}^Q(f) \right)$$

•
$$PSD_{v_n}(f) = 2 \cdot 4KT(\frac{1}{gm_{diff}}(\frac{2}{3} + \frac{1}{gm_{diff}R}))$$

Calculamos:

•
$$gm_{diff} = \sqrt{\frac{I_{bias}}{2} \cdot \frac{2K_pw}{l}} = 80 \ uA/V$$

•
$$\frac{v_{out}}{v_{diff}} = gm_{diff}R \approx 3.8$$

•
$$PSD_{v_n}(f) \approx 4KT \cdot \left(\frac{1.85}{gm_{diff}}\right) \approx 382.9 \frac{nV^2}{Hz} \text{ or } 19.5 \frac{nV}{\sqrt{Hz}}$$

31

•
$$R_{eq} = \frac{1.85}{gm_{diff}} = 23.12K\Omega$$

• Comparando con bipolar: $R_{eq}=2.5K\Omega$



Contenido Clase 12

• Ruido:

- Introducción a ruido
- Ruido en resistencias
- Ruido en bipolares
- Ruido en mos
- Ruido en amplificadores
- · Técnicas de eliminación de offset y ruido flicker



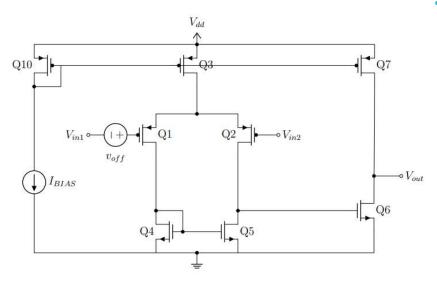
Offset de amplificadores

•
$$w_{10} = w_3 = w_8 = 10 \ um; w_7 = \frac{w_3}{2}$$

•
$$w_4 = w_5 = w_6 = 10 \ um$$

•
$$w_1 = w_2 = 80 \ um$$

• all l = 4 um



• Ejemplo:

• Calcular el sigma de vn del amplificador. Asumiendo: $\sigma_{V_t}^P = 25 \text{ mV.um, Kn} = 120\text{uA/V}^2$, Kp = 40uA/V^2, Vt = 0.7V, λ = 0.08 um/V y Ibias = 10uA. No considerar el ruido flicker.

Solución:

2C-2024 33

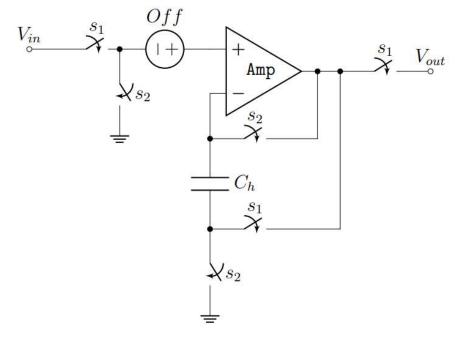


Contenido Clase 12

- Ruido:
 - Introducción a ruido
 - Ruido en resistencias
 - Ruido en bipolares
 - Ruido en mos
 - Ruido en amplificadores
 - · Técnicas de eliminación de offset y ruido flicker



- · Técnicas de eliminación de offset y ruido flicker
 - Técnica de Autozero:
 - El objetivo es muestrear el offset y el ruido de bajas frecuencias (esencialmente el flicker).
 - · Requiere dos fases:
 - Fase A: se muestrea el offset en el capacitor Ch cerrando los switches S2
 - Fase B: Se conecta la entrada a la salida y el offset se substrae.
 - Dado que la Vout no esta presente en forma continua, normalmente se samplea la salida.
 - Dado que se muestrea el amplificador una vez previo a presentar la salida, el sigma del ruido térmico puede ser hasta raíz de 2 veces mayor de lo que seria sin eliminar el offset y samplear la salida.



2C-2024

35

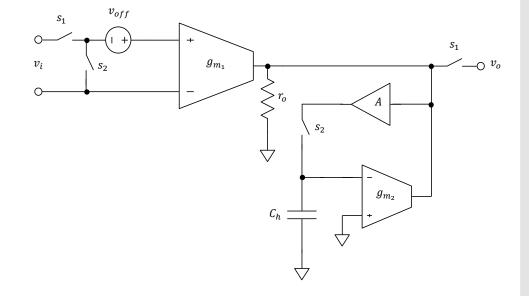


- · Técnicas de eliminación de offset y ruido flicker
 - Técnica de Autozero: Ejemplo1
 - En la fase A, se cierran los switches S2 y el sistema fuerza la salida a cero absorbiendo la corriente generada por la fuente voff, guardando el estado en el capacitor Ch:

$$\begin{aligned} & \cdot & (v_{off}gm_1 - (v_o \cdot A \cdot gm_2) \cdot r_o = v_o \\ & \cdot & v_o = \frac{r_ogm_1}{1 + A \cdot gm_2 r_o} \cdot v_{off} \approx \frac{gm_1}{A \cdot gm_2} \cdot v_{off} \end{aligned}$$

- · Sin aplicar esta técnica:
 - $v_o = gm_1r_o \cdot v_{off}$
- Mejora:

$$\bullet \ \, \frac{v_{off}}{v_{off}^{comp}} = \frac{v_{out}}{v_{out}^{comp}} = \frac{gm_1r_o \cdot v_{off}}{\frac{gm_1}{A \cdot gm_2} \cdot v_{off}} = A \cdot gm_2 \cdot r_0$$



36



- · Técnicas de eliminación de offset y ruido flicker
 - Técnica de Autozero: Implementación Ejemplo1
 - En la fase A, se cierran los switches S2 y el sistema fuerza la salida a Vdd/2:

•
$$(v_{off}gm_1-(v_o+v_{off}')\cdot gm_1{'})\cdot r_o=v_o$$
 and $r_o=r_{o6}\parallel r_{o7}$

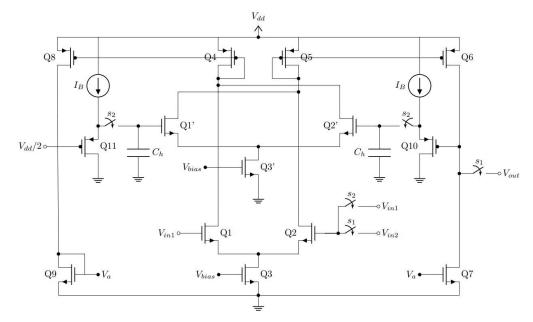
$$\cdot \ \, v_o = \frac{r_o \cdot (gm_1v_{off} + gm_1'v_{off}')}{1 + gm_1'r_o} \approx \frac{gm_1}{gm_1'} v_{off} + v_{off}'$$

· Sin aplicar esta técnica:

•
$$v_o = gm_1r_o \cdot v_{off}$$

Mejora:

$$\frac{v_{off}}{v_{off}^{comp}} = \frac{v_{out}}{v_{out}^{comp}} = \frac{gm_1r_o \cdot v_{off}}{\frac{gm_1}{gm_1^f} v_{off} + v_{off}'} = \frac{gm_1 = gm_1'}{v_{off} = v_{off}'} \frac{gm_1r_o}{2}$$



- $Q_8 = Q_4 = Q_5 = Q_6$
- $Q_9 = Q_7; Q_{11} = Q_{10}$ $Q_1 = Q_2; Q'_1 = Q'_2$
- $Id_3' = I_{bias}'$
- $Id_3 = I_{bias}$
- v_{off} : offset referido a la entrada del amplificador
- v_{off}' : offset referido a la entrada del circuito auxiliar $(Q_1', Q_2', Q_{11}, Q_{10})$ Bias)



- · Técnicas de eliminación de offset y ruido flicker
 - Técnica de Chopper:
 - La idea es modular la entrada a la frecuencia fch para separarla de voff y del ruido de baja frecuencia.
 - Luego se amplifica la señal junto con el ruido, se demodula pasando de vuelta la señal a banda base y corriendo voff a fch.
 - Finalmente, se filtra para remover voff.
 - Esta técnica permite tener la señal de forma continua a la salida.

